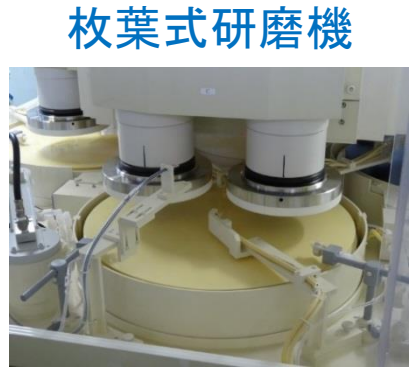


NEW

第45回 ネプコン ジャパン出展  
 会期:2016/1/14(水)~16(木)  
 東6ホール ブースNo.E52-32

■ セミコン 韓国出展  
 会期:2016/1/27(水)~29(木)  
 ソウル COEX  
 Hall A ブースNo.2154



《SiC加工》(サファイア・GaN加工)

- ラップ研磨からグラインド研削へ
- 研削加工で加工時間, コストを低減

高剛力 研削



ファイン仕上げ表面粗さ  
 $Ra < 0.6 \sim 0.8nm$

ファイン仕上げ反り  
 $0.2 \sim 0.4mm$

前工程の加工ダメージ低減とCMP バッチ研磨

- 高速・超平滑面を得るCMP



SiCウエーハSi面CMP表面粗さ  
 $Ra < 0.1nm (1 \text{ \AA})$

パーティクル, 金属汚染除去洗浄

RCA 洗浄

- 清浄面に洗浄
- パーティクル
- $T/M: \leq 10 \text{個/WF} (\geq 0.3um)$
- 金属汚染
- $B/M: < 5 \times 10^{10} \text{atoms/cm}^2$

